

# 2SC1913, 2SC1913A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

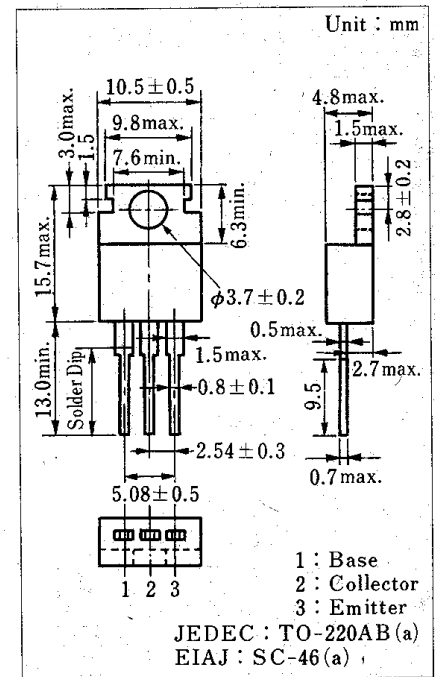
2SA913, 2SA913A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SA913, 2SA913A

### ■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ電圧  $V_{CEO}$  が高い。 / High  $V_{CEO}$
- コレクタ損失  $P_C$  が大きい。 / Large  $P_C$
- 2SA913, 2SA913A とコンプリメンタリペアで出力 60~100 W のドライバに最適です。  
60~100 W driver in complementary pair with 2SA913, 2SA913A

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SC1913	150	V
	2SC1913A	180	
コレクタ・エミッタ電圧	2SC1913	150	V
	2SC1913A	180	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	1.5	A
コレクタ電流	$I_C$	1	A
コレクタ損失 ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	15	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	2SC1913	$I_C = 100 \mu\text{A}, I_B = 0$	150			V
	2SC1913A		180			
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E = 10 \mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE} = 10 \text{V}, I_C = 150 \text{mA}$	65		330	
	$h_{FE2}$	$V_{CE} = 5 \text{V}, I_C = 500 \text{mA}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	2SC1913	$I_C = 300 \text{mA}, I_B = 30 \text{mA}$			1	V
	2SC1913A				1.5	
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 300 \text{mA}, I_B = 30 \text{mA}$			1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB} = 10 \text{V}, I_E = -50 \text{mA}$		120		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 100 \text{V}, I_E = 0, f = 1 \text{MHz}$			15	pF

\* $h_{FE1}$  ランク分類 /  $h_{FE1}$  Classifications

Class	P	Q	R	S
$h_{FE1}$	65~110	90~155	130~220	185~330